

Список основных публикаций ведущей организации **Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический Университет имени Ж.И. Алфёрова Российской Академии Наук»:**

1. Буравлев А.Д., Кузьмин В.А., Мохов Д.В., Казакин А.Н., Кириленко Д.А., Нащекина Ю.А., Нащекин А.В., Убыйвовк Е.В., Астраханцева В.А., Осипов А.В., Святец Г.В., Кукушкин С.А., «Полупроводниковые квазиодномерные структуры: новые методы синтеза и обработки», В сборнике: Мокеровские чтения. Сборник трудов 14-ой Международной научно-практической конференции по физике и технологии наногетероструктурной СВЧ-электроники. Москва, 2023. С. 106-107.
2. Жуков А.Е., Крыжановская Н.В., Махов И.С., Моисеев Е.И., Надточий А.М., Фоминых Н.А., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Зубов Ф.И., Максимов М.В., «Модель быстрогодействия волноводного фотодиода с квантовыми точками», Физика и техника полупроводников. 2023. Т. 57. № 3. С. 215-220.
3. Зубов Ф.И., Шерняков Ю.М., Гордеев Н.Ю., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В., Крыжановская Н.В., Моисеев Э.И., Надточий А.М., Жуков А.Е., «Сверхвысокое модовое усиление в инжекционных полосковых лазерах и микролазерах на основе квантовых точек InGaAs/GaAs», Квантовая электроника. 2022. Т. 52. № 7. С. 593-596.
4. Kryzhanovskaya N.V., Likhachev A.I., Blokhin S.A., Blokhin A.A., Pirogov E.V., Sobolev M.S., Egorov A.Y., Babichev A.V., Gladyshev A.G., Karachinsky L.Y., Novikov I.I., Andryushkin V.V., Denisov D.V., «1.3 μm optically-pumped monolithic VCSEL based on GaAs with InGa(Al)As», Laser Physics Letters. 2022. Т. 19. № 7. С. 075801.
5. Андрюшкин В.В., Драгунова А.С., Комаров С.Д., Надточий А.М., Гладышев А.Г., Бабичев А.В., Уваров А.В., Новиков И.И., Колодезный Е.С., Карачинский Л.Я., Крыжановская Н.В., Неведомский В.Н., Егоров А.Ю., Бугров В.Е., «Влияние низких температур и термического отжига на оптические свойства квантовых точек InGaPAs», Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2022. Т. 22. № 5. С. 921-928.
6. Бабичев А.В., Пирогов Е.В., Соболев М.С., Денисов Д.В., Фоминых Н.А., Баранов А.И., Гудовских А.С., Мельниченко И.А., Юнин П.А., Неведомский В.Н., Токарев М.В., Бер Б.Я., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю., «Исследование активных областей на основе многопериодных сверхрешеток GaAsN/InAs», Физика и техника полупроводников. 2022. Т. 56. № 10. С. 1002-1010.